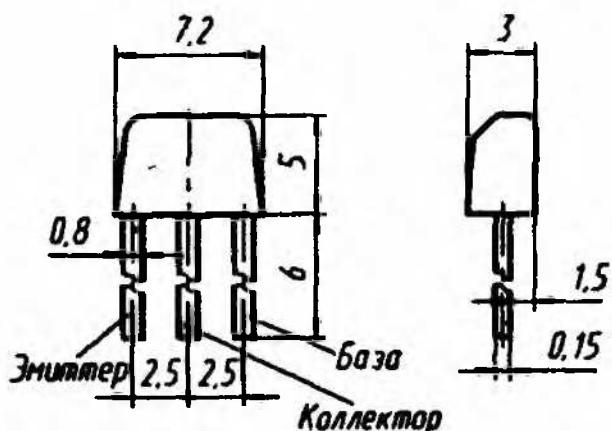


# КТ361А, КТ361Б, КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е

## КТ361(А-Е)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $p-p-n$  усиленные. Предназначены для применения в усилителях высокой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,3 г.

## Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока  
в схеме ОЭ при  $U_{KB} = 10$  В,  $I_K = 1$  мА:

$T = +25$  °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е .....	50...350
КТ361В.....	40...160

$T = +100$  °С:

КТ361А, КТ361Д.....	20...250
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е .....	50...500
КТ361В.....	20...300

$T = -60$  °С:

КТ361А, КТ361Д.....	10...90
КТ361Б, КТ361Г, КТ361Е .....	15...350
КТ361В.....	10...160

Границная частота коэффициента передачи  
тока при  $U_{K3} = 10$  В,  $I_3 = 5$  мА, не менее ..... 250 МГц

Постоянная времени цепи обратной связи

при  $U_{KB} = 10$  В,  $I_3 = 5$  мА,  $f = 5$  МГц, не более:

КТ361А, КТ361Б, КТ361Г .....	500 пс
КТ361В, КТ361Е .....	1000 пс
КТ361Д.....	250 пс

Обратный ток коллектора при  $U_{KB} = 10$  В,  
не более:

$T = +25$ и $-60$ °С .....	1 мкА
$T = +100$ °С .....	25 мкА

Обратный ток коллектор—эмиттер

при  $R_{B3} = 10$  кОм,  $U_{K3} = U_{K3, \text{ макс.}}$ , не более ..... 1 мкА

Емкость коллекторного перехода

при  $U_{K3} = 10$  В, не более:

КТ361А, КТ361Б ..... 9 пФ

КТ361В, КТ361Г, КТ361Д, КТ361Е ..... 7 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянные напряжения коллектор—база,

коллектор—эмиттер<sup>1</sup> при  $R_{B3} = 10$  кОм:

$T \leq +35$  °C:

КТ361А ..... 25 В

---

<sup>1</sup> В диапазоне температур +35...+100 °C допустимое значение напряжения коллектор—эмиттер снижается линейно.

КТ361Б ..... 20 В

КТ361В, КТ361Д ..... 40 В

КТ361Г, КТ361Е ..... 35 В

$T = +100$  °C:

КТ361А ..... 20 В

КТ361Б ..... 15 В

КТ361В, КТ361Д ..... 35 В

КТ361Г, КТ361Е ..... 30 В

Постоянное напряжение база—эмиттер ..... 4 В

Постоянный ток коллектора ..... 50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллек-

тора<sup>1</sup>:

$T \leq +35$  °C ..... 150 мВт

$T = +100$  °C ..... 30 мВт

Температура р-п перехода ..... +120 °C

Температура окружающей среды ..... -60...+100 °C

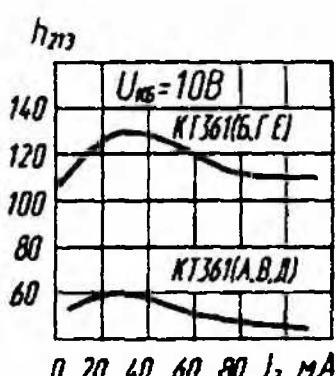
---

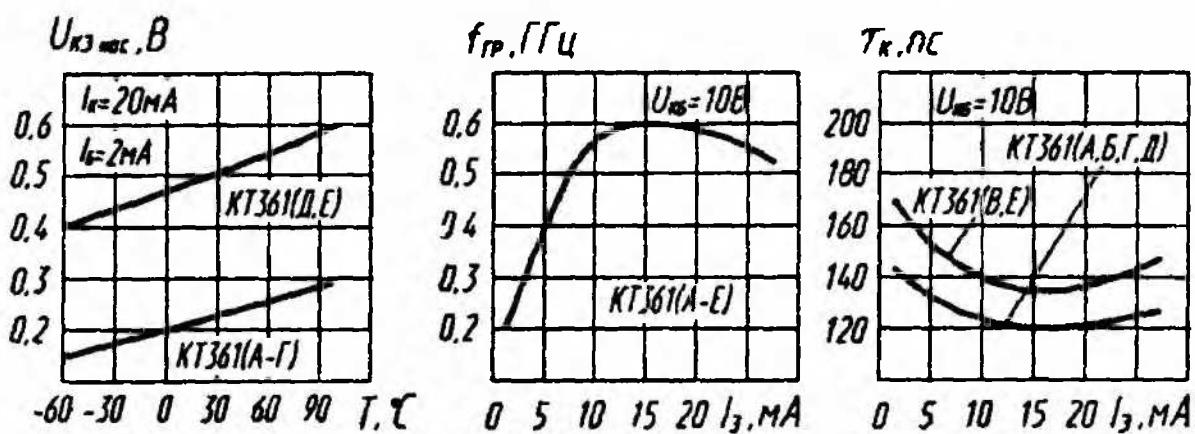
<sup>1</sup> В диапазоне температур +35...+100 °C допустимое значение рассеиваемой мощности снижается линейно.

Допускается трехкратный изгиб выводов не ближе 2 мм от корпуса транзистора с радиусом закругления 1,5...2 мм.

Минимально допустимое расстояние от места пайки выводов до корпуса 2 мм.

Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера





Зависимости напряжения насыщения коллектор—эмиттер от температуры

Зависимость граничной частоты от тока эмиттера

Зависимости постоянной времени цепи обратной связи от тока эмиттера